

Germanium PNP Transistor

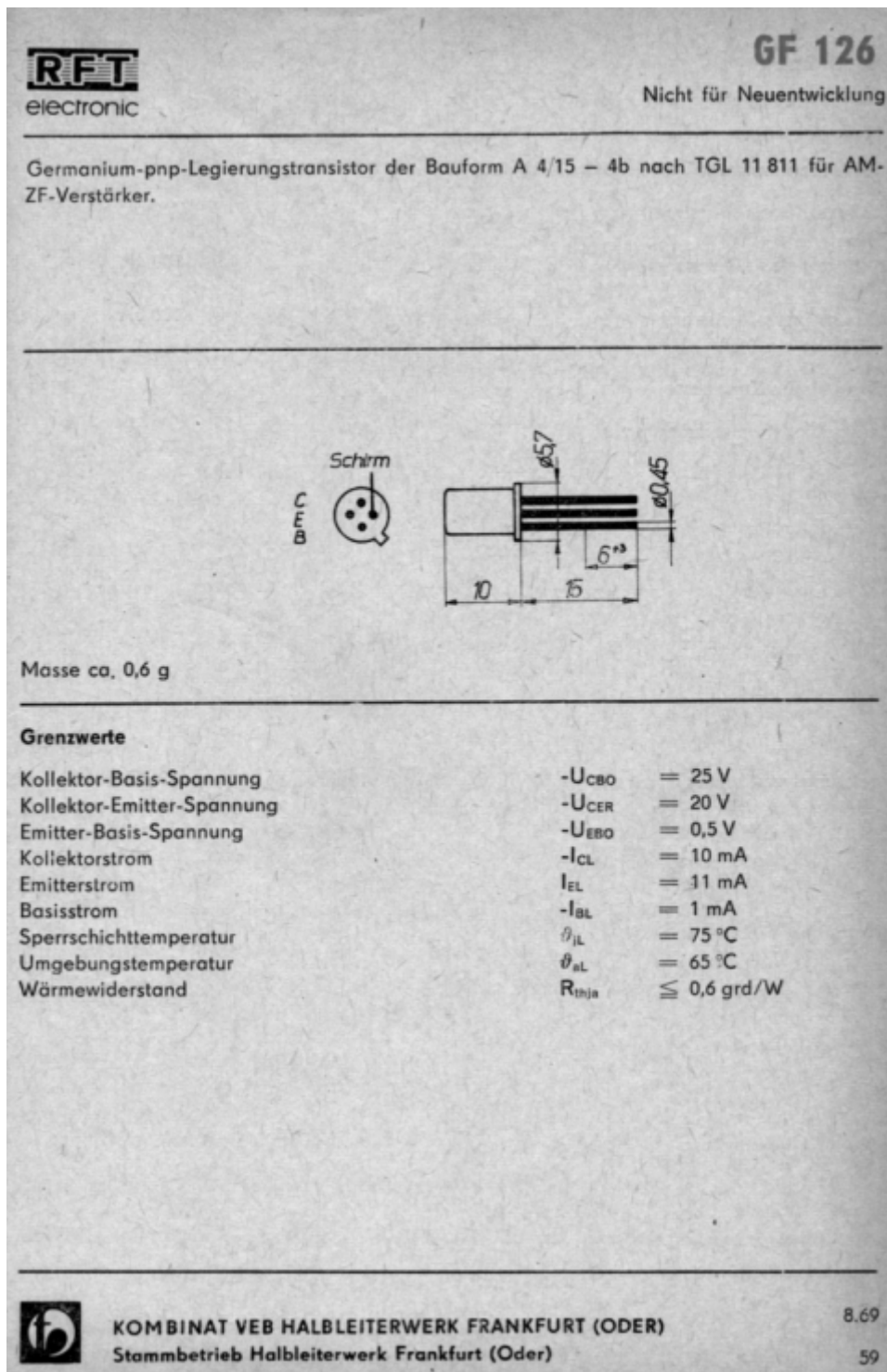
GF126

25V / 10mA

DATASHEET

OEM – RFT

Source: RFT Datenbuch Germanium Transistoren 71/72



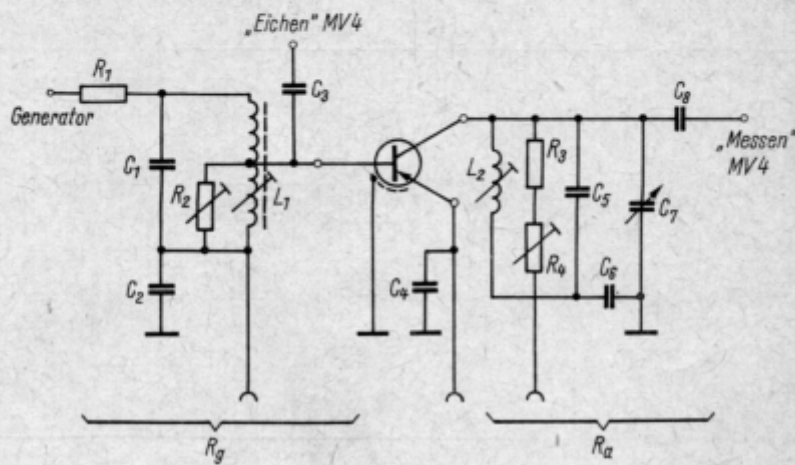
GF 126		RFT electronic		
Nicht für Neuentwicklung				
Statische Kennwerte		Min.	Typ	Max.
Kollektor-Basis-Reststrom -U _{CB} = 6 V	-I _{CBO}			7,5 μA
Kollektor-Basis-Reststrom -U _{CB} = 25 V	-I _{CBO}			100 μA
Emitter-Basis-Reststrom -U _{EB} = 0,5 V	-I _{EBO}			100 μA
Dynamische Kennwerte				
Kurzschlußstromverstärkung -U _{CE} = 6 V -I _C = 1 mA	h _{21E}	40		
Vierpolparameter	$\frac{1}{g_{11e}}$		3,0 kΩ	
-U _{CE} = 6 V	C _{11e}		65 pF	
-I _C = 1 mA	C _{12e}	1 pF		2,1 pF
f = 500 kHz	y _{21e}		35 mS	
	$\frac{1}{g_{22e}}$		277 kΩ	
	C _{22e}		4,4 pF	
Leistungsverstärkung -U _{CE} = 6 V -I _C = 1 mA f = 500 kHz	G _{pe}	40 dB		42 dB
Siehe Meßschaltung Seite 61				
8.69	KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)			
60	Stammbetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)			

RFT
electronic

GF 126
Nicht für Neuentwicklung

Die Leistungsverstärkung G_{pe} wird in folgender Meßschaltung nach der Beziehung

$$G_{pe} = 4 \left| \frac{U_a}{U_g} \right|^2 \cdot \frac{R_g}{R_a} \text{ ermittelt.}$$



- | | |
|-------------------------------|---|
| $C_1 = 1 \text{ nF}$ | $R_1 = 180 \ \Omega$ |
| $C_2 = 0,1 \ \mu\text{F}$ | $R_2 = \text{so eingestellt, da\ss sich ein } R_g \text{ von } 180 \ \Omega \text{ ergibt}$ |
| $C_3 = 1 \text{ nF}$ | $R_3 = 20 \text{ k}\Omega$ |
| $C_4 = 0,47 \ \mu\text{F}$ | $R_4 = \text{so eingestellt, da\ss sich ein } R_a \text{ von } 15 \text{ k}\Omega \text{ ergibt}$ |
| $C_5 = 1 \text{ nF}$ | |
| $C_6 = 0,1 \ \mu\text{F}$ | |
| $C_7 = 4 \dots 50 \text{ pF}$ | |

Bestellbeispiel für einen Transistor

Transistor GF 126



KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
Stammbetrieb Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

8.69

61

